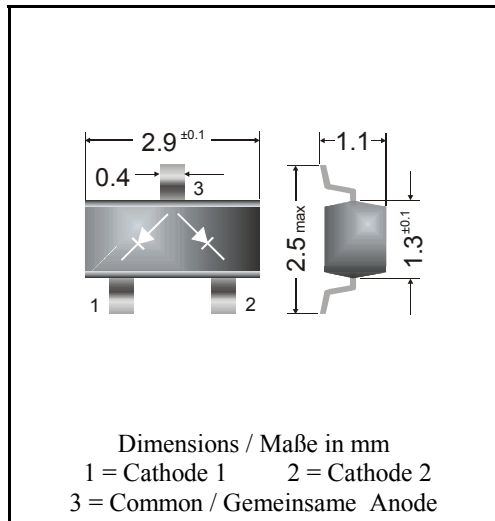


**Dual Surface Mount
Silicon Planar Zener Diodes**

**Silizium-Planar-Zener Doppel-Dioden
für die Oberflächenmontage**

Common Anode

Gemeinsame Anode



Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	300 mW
ΔV_Z for both diodes in one case ΔV_Z beider Dioden in einem Gehäuse	$\leq 5 \%$
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung	3.0...47 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.

Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings

Grenz- und Kennwerte

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	300 mW ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	$-50...+150^\circ\text{C}$ $-50...+150^\circ\text{C}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	$< 420 \text{ K/W}^{1)}$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	$< 0.9 \text{ V}$
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------	-------------------

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Marking Stempel	Zener voltage ¹⁾ Zener-Spanng. ¹⁾ I _Z = 5 mA		Dynamic resistance Inhär. diff. Widerstand r _{zj} [Ω] at f = 1 kHz I _Z = 5 mA I _Z = 1 mA		Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. α _{VZ} [10 ⁻⁴ / °C]	Reverse current Sperrstrom I _R [nA] V _R [V]		Z-current ²⁾ Z-Strom ²⁾ T _A = 25 °C I _{Zmax} [mA]
2BZX84 ...									
... C3V0A	WW5	2.8	3.2	< 100	< 600	-8...-5	4000	1	109
... C3V3A	WW6	3.1	3.5	< 95	< 600	-8...-5	2000	1	100
... C3V6A	WW7	3.4	3.8	< 95	< 600	-8...-5	2000	1	92
... C3V9A	WW8	3.7	4.1	< 90	< 600	-8...-5	2000	1	85
... C4V3A	WW9	4.0	4.6	< 90	< 600	-6...-3	1000	1	76
... C4V7A	ZZ1	4.4	5.0	< 80	< 500	-5...+2	3000	2	70
... C5V1A	ZZ2	4.8	5.4	< 60	< 480	-2...+2	2000	2	65
... C5V6A	ZZ3	5.2	6.0	< 40	< 400	-5...+5	1000	2	58
... C6V2A	ZZ4	5.8	6.6	< 10	< 150	+3...+6	3000	4	53
... C6V8A	ZZ5	6.4	7.2	< 10	< 80	+3...+7	2000	4	49
... C7V5A	ZZ6	7.0	7.9	< 10	< 80	+3...+7	1000	5	44
... C8V2A	ZZ7	7.7	8.7	< 10	< 80	+3...+8	700	5	40
... C9V1A	ZZ8	8.5	9.6	< 15	< 100	+3...+9	500	6	36
... C10A	ZZ9	9.4	10.6	< 20	< 150	+3...+10	200	7	33
... C11A	YY1	10.4	11.6	< 20	< 150	+3...+11	100	8	30
... C12A	YY2	11.4	12.7	< 25	< 150	+3...+11	100	8	28
... C13A	YY3	12.4	14.1	< 30	< 170	+3...+11	100	8	25
... C15A	YY4	13.8	15.6	< 30	< 200	+3...+11	50	10	22
... C16A	YY5	15.3	17.1	< 40	< 200	+3...+11	50	11	20
... C18A	YY6	16.8	19.1	< 50	< 225	+3...+11	50	13	18
... C20A	YY7	18.8	21.2	< 50	< 225	+3...+11	50	14	17
... C22A	YY8	20.8	23.3	< 55	< 250	+4...+12	50	15	15
... C24A	YY9	22.8	25.6	< 80	< 250	+4...+12	50	17	14
		I _Z = 2 mA		I _Z = 0.5 mA					
... C27A	W10	25.1	28.9	< 80	< 300	+4...+12	50	19	12
... C30A	W11	28	32	< 80	< 300	+4...+12	50	21	11
... C33A	W12	31	35	< 80	< 325	+4...+12	50	23	10
... C36A	W13	34	38	< 90	< 350	+4...+12	50	25	9
... C39A	W14	37	41	< 90	< 350	+4...+12	50	27	9
... C43A	W15	40	46	< 100	< 375	+4...+12	50	30	8
... C47A	W16	44	50	<100	< 375	+4...+12	50	33	7

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 5 \text{ ms}$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 5 \text{ ms}$
²⁾ Per diode - mounted on P.C. board with 25 mm^2 copper pads at each terminal

Pro Diode - bei Montage auf Leiterplatte mit 25 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß